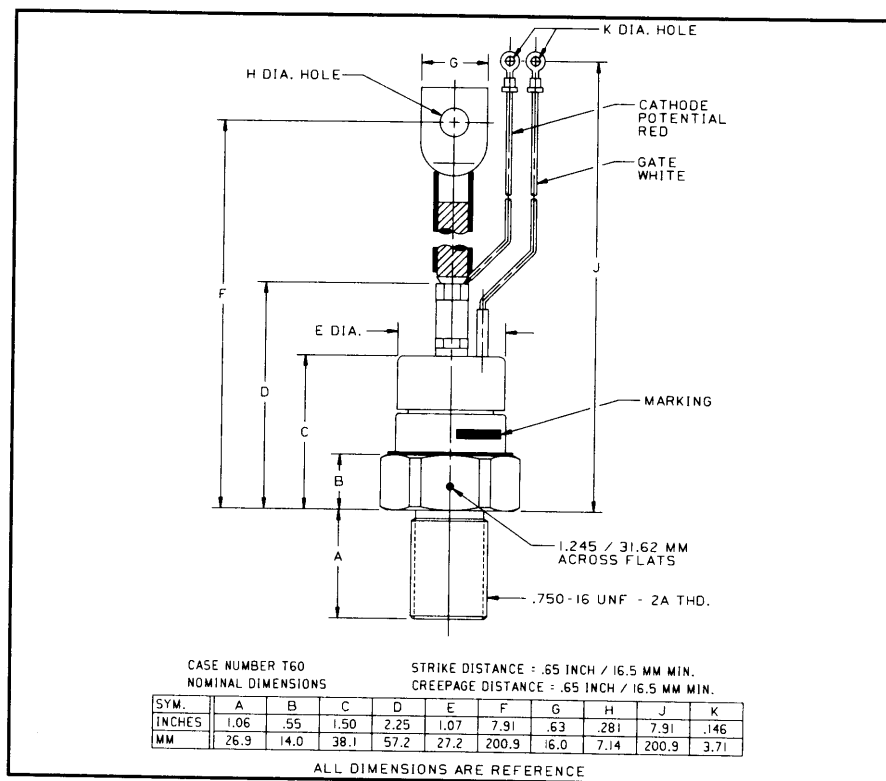
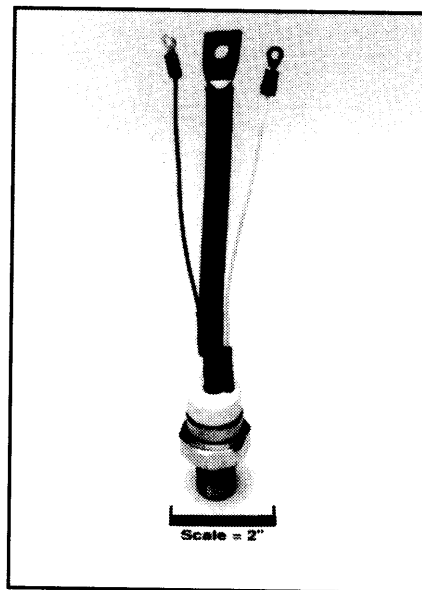


Phase Control SCR 190 Amperes Average 600 Volts



C180__X500 (Outline Drawing)



C180__X500 Phase Control SCR
190 Amperes Average, 600 Volts

Ordering Information:

Select the complete nine digit part number you desire from the table, i.e. C180MX500 is a 600 Volt, 190 Ampere Phase Control SCR.

Type	Voltage		Current
	V _{DRM} V _{RRM}	Code	
C180__X500	100	A	190
	200	B	
	300	C	
	400	D	
	500	E	
	600	M	

Description:

Powerex Silicon Controlled Rectifiers (SCR) are designed for phase control applications. These are all-diffused, compression bonded encapsulated (CBE) devices employing the field-proven amplifying (di/namic) gate.

Features:

- ☐ Low On-State Voltage
- ☐ High di/dt
- ☐ High dv/dt
- ☐ Hermetic Packaging
- ☐ Excellent Surge and I²t Ratings

Applications:

- ☐ Power Supplies
- ☐ Battery Chargers
- ☐ Motor Control

Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
 Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

C180_X500
 Phase Control SCR
 190 Amperes Average, 600 Volts

Absolute Maximum Ratings

	Symbol	C180_X500	Units
RMS On-State Current @ $T_C = 92^\circ\text{C}$	$I_{T(RMS)}$	300	Amperes
Average On-State Current @ $T_C = 92^\circ\text{C}$	$I_{T(av)}$	190	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non Repetitive) On-State Current (60Hz)	I_{TSM}	5500	Amperes
Peak One-Cycle Surge (Non-Repetitive) On-State Current (50Hz)	I_{TSM}	5000	Amperes
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Non-Repetitive)	di/dt	800	Amperes/ μs
Critical Rate-of-Rise of On-State Current (Repetitive)	di/dt	150	Amperes/ μs
I^2t (for Fusing), 8.3 milliseconds	I^2t	125,000	A^2sec
Peak Gate Power Dissipation	P_{GM}	10	Watts
Average Gate Power Dissipation	$P_{G(av)}$	2	Watts
Storage Temperature	T_{STG}	-40 to 150	$^\circ\text{C}$
Operating Temperature	T_J	-40 to 125	$^\circ\text{C}$
Mounting Torque		250 to 300	in.-lb.
Mounting Torque		28 to 34	N-M

Electrical and Thermal Characteristics

Characteristics	Symbol	Test Conditions	C180_X500	Units
Voltage—Blocking State Maximums				
Forward Leakage, Peak	I_{DRM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_{DRM} = \text{Rated}$	20	mA
Reverse Leakage, Peak	I_{RRM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, $V_{RRM} = \text{Rated}$	20	mA
Current—Conducting State Maximums				
Peak On-State Voltage	V_{TM}	$T_J = 25^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 900\text{A Peak}$	1.75	Volts
Switching				
Typical Turn-Off Time	t_q	$I_T = 150\text{A}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$, $di_R/dt = 12.5\text{A}/\mu\text{sec}$ Reapplied $dv/dt = 20\text{V}/\mu\text{sec}$, Linear to $0.8 V_{DRM}$, $V_R = 50\text{V}$	100	μsec
Typical Delay Time	t_d	$I_T = 100\text{A}$, $V_{DRM} = \text{rated}$; Gate supply: 10V, open circuit; $R_L = 25\Omega$, 0.1 μsec rise time	1.0	μsec
Min. Critical dv/dt exponential to V_{DRM}	dv/dt	$T_J = 125^\circ\text{C}$, Gate Open	200	$\text{V}/\mu\text{sec}$
Thermal				
Maximum Thermal Resistance Junction to Case	$R_{\theta JC}$		0.14	$^\circ\text{C}/\text{Watt}$
Case to Sink, Lubricated	$R_{\theta CS}$		0.075	$^\circ\text{C}/\text{Watt}$
Gate—Maximum Parameters				
Gate Current to Trigger	I_{GT}	$T_C = 25^\circ\text{C}$; $V_D = 6\text{Vdc}$, $R_L = 3\Omega$	150	mA
Gate Voltage to Trigger	V_{GT}	$T_C = -40^\circ\text{C}$ to 125°C , $V_D = 6\text{Vdc}$, $R_L = 3\Omega$	3.0	Volts
Non-Triggering Gate Voltage	V_{GDM}	$T_J = 125^\circ\text{C}$, Rated V_{DRM} , $R_L = 1000\Omega$	0.15	Volts
Peak Forward Gate Current	I_{GTM}		10	Amperes
Peak Reverse Gate Voltage	V_{GRM}		5	Volts

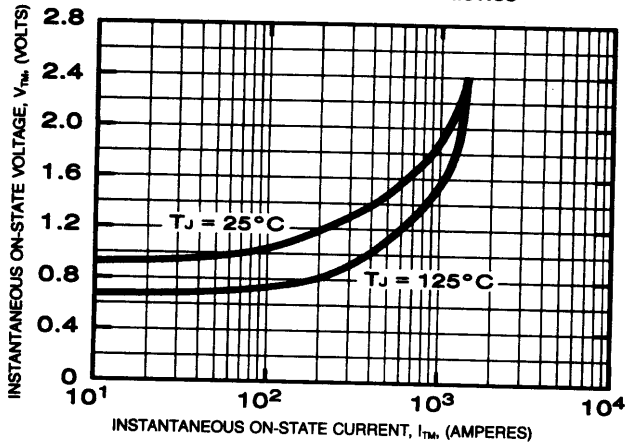
Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

C180 X500

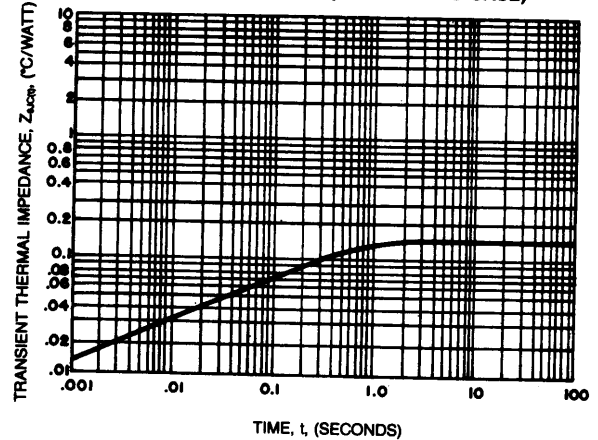
Phase Control SCR

190 Amperes Average, 600 Volts

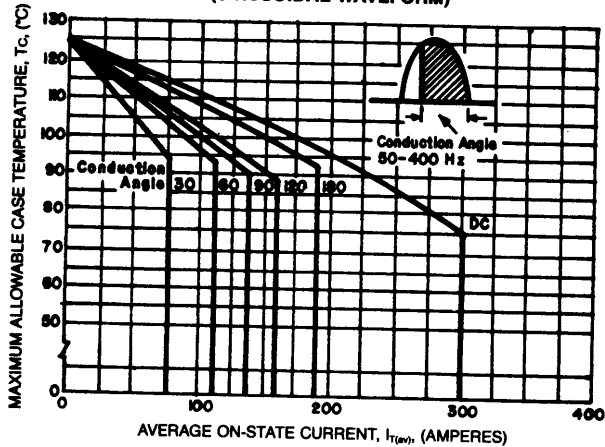
MAXIMUM ON-STATE CHARACTERISTICS



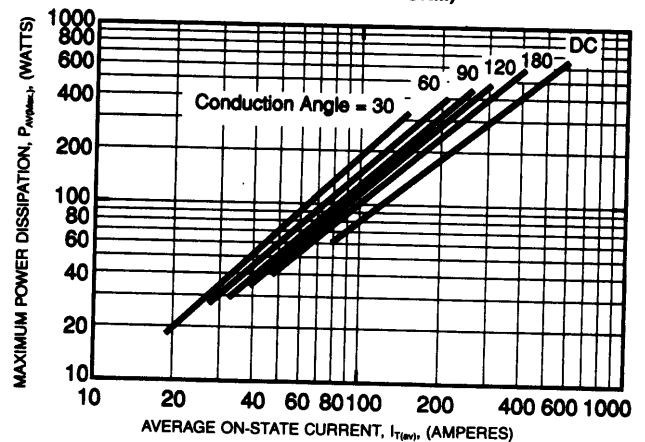
TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE CHARACTERISTICS (JUNCTION TO CASE)



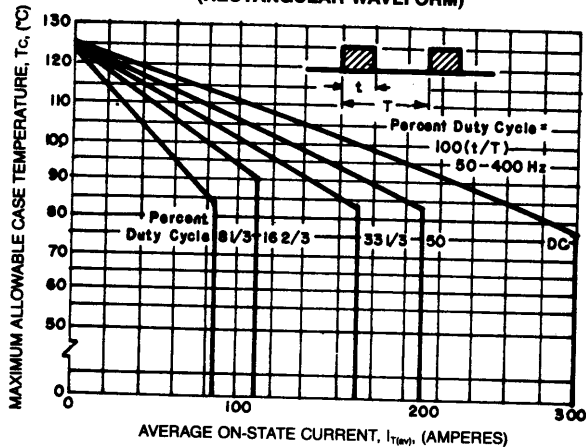
MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE (SINUSOIDAL WAVEFORM)



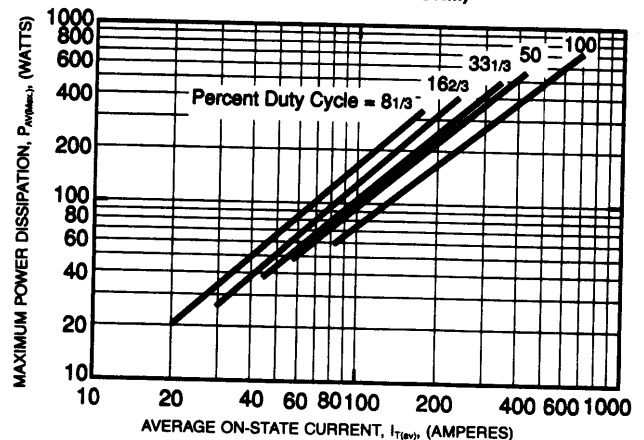
MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION (SINUSOIDAL WAVEFORM)



MAXIMUM ALLOWABLE CASE TEMPERATURE (RECTANGULAR WAVEFORM)



MAXIMUM ON-STATE POWER DISSIPATION (RECTANGULAR WAVEFORM)



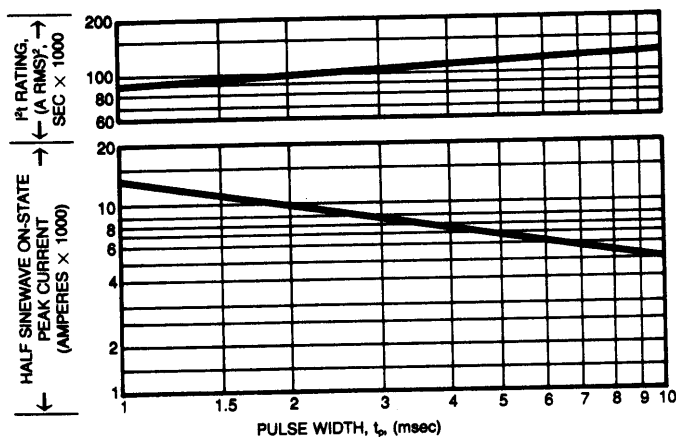
Powerex, Inc., 200 Hillis Street, Youngwood, Pennsylvania 15697-1800 (412) 925-7272
 Powerex, Europe, S.A. 428 Avenue G. Durand, BP107, 72003 Le Mans, France (43) 41.14.14

C180_X500

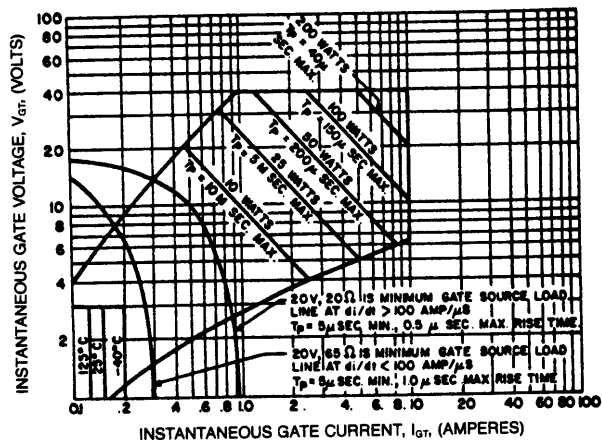
Phase Control SCR

190 Amperes Average, 600 Volts

SUB-CYCLE SURGE AND I_{T1} RATINGS
 (RATED LOAD CONDITIONS)



GATE CHARACTERISTICS



NOTES:

1. Maximum allowable gate power dissipation = 2 watts.
2. The locus of possible DC trigger points lie outside the boundaries shown at various case temperatures.
3. T_p = rectangular gate current pulse width.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331